



- 首页
- 学校要闻
- 领导讲话
- 专题报道
- 综合新闻
- 院系动态
- 国际事务
- 校友动态
- 招生就业
- 复旦人物
- 专家视点
- 复旦讲堂
- 校园生活
- 校史通讯
- 复旦书屋
- 相辉笔会
- 通知公告
- 媒体视

复旦新闻文化网 新闻 综合新闻

黄均鼐、汤庭鳌教授和胡光喜副教授编撰的《半导体器件原理》荣获中国电子教育学会一等奖

作者：马波来源：信息学院发布时间：2013-01-25 中字体

黄均鼐、汤庭鳌教授和胡光喜副教授编撰的《半导体器件原理》荣获中国电子教育学会全国电子信息类优秀教材（研究生、本科生教育优秀教材）一等奖。本书是在20年前黄均鼐教授和汤庭鳌教授合著的《双极型与MOS半导体器件原理》基础上一次改版，由复旦大学出版社出版。本书得到上海市科委通过上海自然科学基金项目的支持。

过去20年，集成电路技术得到迅猛发展。MOS半导体器件的特征长度从微米级逐渐向亚微米级、深亚微米级发展，目前已达到32纳米甚至22纳米。新的种类器件如铁电存储器、闪存、阻式存储器、相变存储器等已经得到或即将得到广泛应用。新的材料，如高介电常数材料已经在MOS器件中得到应用。新的结构MOS器件，如双栅器件、围栅器件、鳍栅器件、肖特基势垒源/漏结构器件等，即将被应用到下一代或再下一代MOS器件中。本书不仅介绍半导体器件的物理基础、小尺寸MOSFET的有关效应、几个用于SPICE模拟软件中的模型、肖特基势垒结构器件、新型多栅MOSFET；还进一步阐述双极型晶体管的工作原理及它的直流、频率、开关和功率特性；讨论MOS场效应管、功率管的结构、原理和主要特征；是一本不可多得的半导体技术书籍，

本次评选共收到来自全国13家主要教材出版单位的参评教材200余种。参评教材作者所在院校涉及中东部22个省、直辖市。电子教育学会组织教育专家对参评教材进行了评审，共有68种教材进入终审。专家组对教材的编写水平、内容质量、编校质量以及版式设计等进行全面评估，最终评选出一等奖9名，二等奖24名，三等奖35名。复旦大学信息学院黄均鼐、汤庭鳌教授和胡光喜副教授编撰的《半导体器件原理》就是其中的一等奖之一。

相关文章

已有0位网友发表了看法

[查看评论](#)

推荐	收藏	打印	关闭
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

[本周新闻排行](#)

[相关链接](#)